

平成 30 年度 第 3 回半導体エレクトロニクス部門委員会 第 1 回研究会

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

期 日： 平成 30 年 7 月 21 日（土） 10：30 ～ 17：00（予定）

10:30 ～ 12:00：招待講演

13:00 ～ 17:00：研究発表（口頭講演、質疑応答込 1 件 20 分）

研究発表終了後：情報交換会

会 場： 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域 大講義室

〒630-0192 奈良県生駒市高山町8916-5

アクセス <http://mswebs.naist.jp/access/>

参加費： 無料

半導体エレクトロニクス関連の材料・デバイス応用に関する研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

■部門委員会の賞

優れた発表に対して下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

学生優秀講演賞： 博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

講演奨励賞： 若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定（http://algainn.jsms.jp/?page_id=48）」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿とショートアブストラクトを投稿してください。

<講演申込内容>

- ・ 講演タイトル，著者名，所属，学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

<講演原稿作成要領>

- ・ A4 サイズ 1-4 枚以内（図，表，写真を含む）、日本語または英語
- ・ 1 枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・ pdf ファイルにて投稿

<ショートアブストラクト作成要領>

- ・ 日本語 120 文字以内、英語 40 語以内
- ・ 講演原稿送付期日までに投稿システムの所定欄に投稿

■講演申込期日： 平成 30 年 6 月 22 日（金）

■講演原稿送付期日： 平成 30 年 7 月 13 日（金）

■講演プログラム

プログラムは 7 月上旬に公開予定です。

<招待講演>

龍谷大学 教授 木村睦

アモルファス金属酸化物半導体の研究開発と

エレクトロニクス・エナジーハーベスト・ニューロモフィックデバイスへの新規応用

奈良先端科学技術大学院大学 准教授 石河泰明

Si 太陽電池モジュールにおける電圧誘起劣化現象

奈良先端科学技術大学院大学 助教 上沼睦典

酸化物半導体薄膜の熱電性能と環境発電への展開

■その他

終了後、情報交換会（会費制）を予定しています。是非ご参加ください。

■問合せ先

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学研究領域

浦岡行治

E-mail：uraoka[ア]ms.naist.jp

[ア]は@に置き換えてください。